

KT218A9- KT218E9

МАЛОЙ МОЩНОСТИ СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ
LOW POWER MEDIUM FREQUENCY



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кремниевые биполярные эпитаксиально-планарные p-n-p транзисторы KT218A9 - KT218E9 предназначены для использования в качестве компонентов в гибридных микросхемах с общей герметизацией.

Оформление - в пластмассовом корпусе.

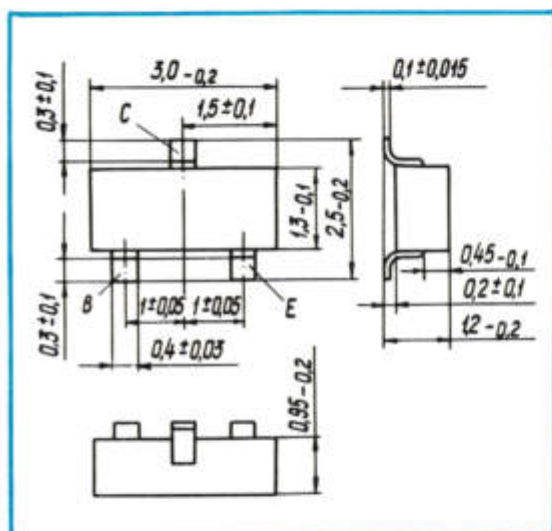
Диапазон допустимых рабочих температур от -60 до +85°C.

GENERAL DESCRIPTION

The KT218A9 - KT218E9 transistors are Silicon bipolar planar-epitaxial p-n-p transistors designed for use as components of hybrid microcircuits with overall hermetization.

The devices are packaged in plastic cases.

Allowable operating temperature: -60 to +85°C.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ BASIC TECHNICAL CHARACTERISTICS

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAXIMUM VALUES OF ALLOWABLE OPERATING CONDITIONS

$U_{CE \max}$ ($R_{BE} \leq 10 \text{ k}\Omega$)

KT218A9, KT218B9	80 V
KT218B9	60 V
KT218Г9	40 V
KT218Д9	30 V
KT218E9	20 V

$U_{EB \max}$

KT218A9	30 V
KT218B9-KT218Д9	7 V
KT218E9	20 V

$I_C \max$ 50 mA

$I_{CM \max}$ ($t_p \leq 10 \text{ ms}$, $Q \geq 100$) 125 mA

$I_B \max$ 20 mA

$P_C \max$ * ($t_{amb} \leq +25^\circ\text{C}$) 200 mW

$t_j \max$ 125°C

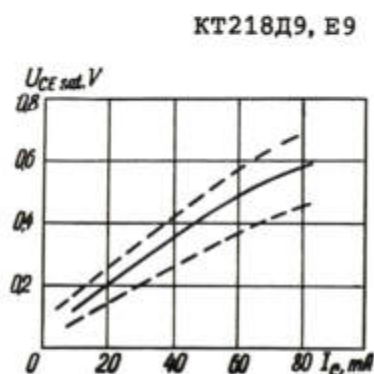
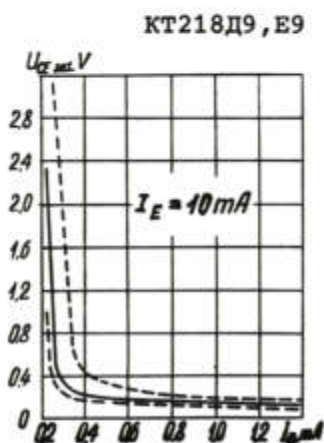
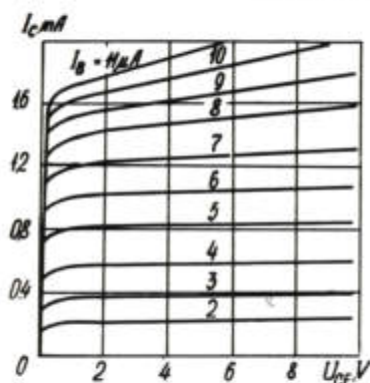
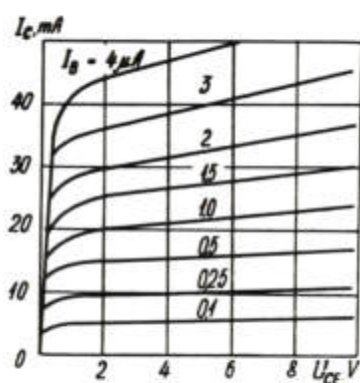
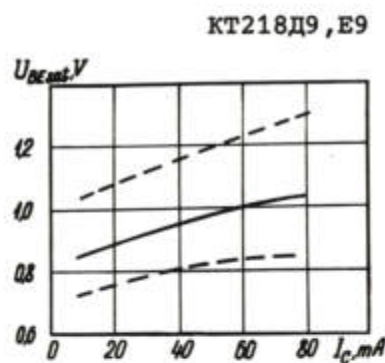
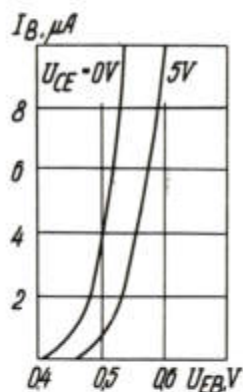
*при $t_{amb} > 25^\circ\text{C} \Rightarrow P_C \max = \frac{t_j \max - t_{amb}}{500^\circ\text{C/W}}$

KT218A9—KT218E9

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ELECTRICAL PARAMETERS

Параметры Parameters	Значения Values	Режимы измерений Measuring conditions			
		$U_{CB}; U_{CE}^x; U_{EB}^{xx}$ V	$I_C; I_E^x; I_B^{xx}$ mA	f MHz	R_{BE} kΩ
$I_{CER}, \mu A$					
KT218A9	< 1	100 ^x			10
KT218B9	< 1	90 ^x			10
KT218B9	< 1	80 ^x			10
KT218Г9	< 1	60 ^x			10
KT218Д9	< 1	30 ^x			10
KT218Е9	< 1	30 ^x			10
$I_{EBO}, \mu A$					
KT218A9	< 10	30 ^{xx}			
KT218B9	< 10	7 ^{xx}			
KT218B9	< 10	7 ^{xx}			
KT218Г9	< 10	7 ^{xx}			
KT218Д9	< 10	7 ^{xx}			
KT218Е9	< 10	20 ^{xx}			
h_{21E}					
KT218A9	> 20	5	10 ^x		
KT218B9	30 - 90	5	10 ^x		
KT218B9	40 - 120	5	10 ^x		
KT218Г9	40 - 120	5	10 ^x		
KT218Д9	> 80	1	0,04 ^x		
KT218Е9	> 40	1	0,04 ^x		
$U_{CE sat}, V$	< 0,6		10; 1 ^{xx}		
$U_{BE sat}, V$	< 1,2		10; 1 ^{xx}		
$f h_{21E}, MHz$	> 5	5	1 ^x	5	
$U_{(L)CEO}, V$					
KT218A9	> 80		10 ^x		
KT218B9	> 80		10 ^x		
KT218B9	> 60		10 ^x		
KT218Г9	> 40		10 ^x		
KT218Д9	> 30		10 ^x		
KT218Е9	> 20		10 ^x		
C_c, pF	< 15	10		1	
C_e, pF	< 20	0,5 ^{xx}		1	

KT218A9—KT218E9



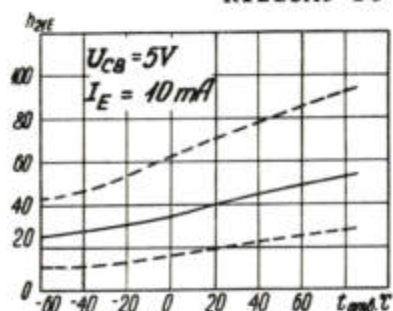
ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



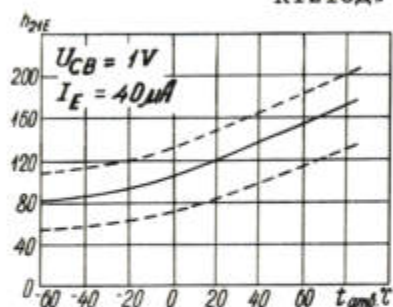
ГРАНИЦЫ
LIMITS OF **95%** РАЗБРОСА
SPREAD

KT218A9—KT218E9

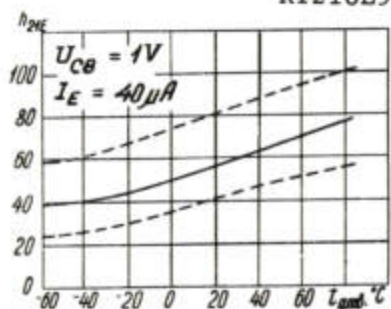
KT218A9-Г9



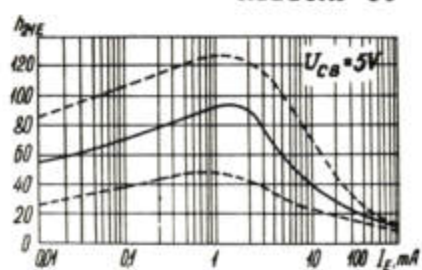
KT218Д9



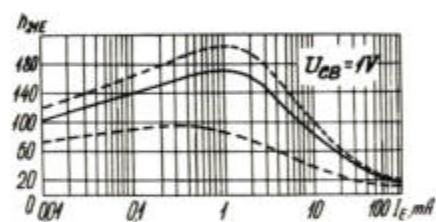
KT218E9



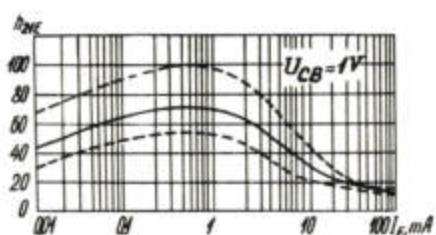
KT218A9-Г9



KT218Д9



KT218E9



ТИПОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
TYPICAL DEPENDENCE



ГРАНИЦЫ
LIMITS OF 95% РАЗБРОСА
SPREAD